

BB 121, BB 122

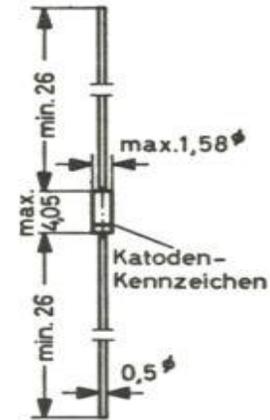
Tuner-Dioden

Silizium-Kapazitätsdioden in Epitaxie-Planar-Technik mit sehr großer nutzbarer Kapazitätsänderung zur Abstimmung über den gesamten Frequenzbereich in VHF- bzw. UHF-Fernsehtunern.

Diese Dioden werden einzeln oder in Bestückungssätzen geliefert (z. B. Terzette oder Quartette).

Glasgehäuse JEDEC DO-35 (Double-Plug)
Gewicht ca. 0,13 p
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden diese Dioden gegurtet geliefert.
Näheres siehe Seite 54.



Grenzwerte

Sperrspannung	U_R	28	V
Sperrschichttemperatur	T_j	150	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_S	-55...+150	°C

Kennwerte bei $T_j = 25\text{ °C}$

		BB 121	BB 122	
Kapazität bei $U_R = 1\text{ V}$ bei $U_R = 3\text{ V}$ bei $U_R = 25\text{ V}$	C_{tot}	17	20	pF
	C_{tot}	11	13	pF
	C_{tot}	2...2,5	2,2...3,2	pF
ausnutzbares Kapazitätsverhältnis bei $U_R = 2,9...25\text{ V}$	$\frac{C_{tot}(2,9\text{ V})}{C_{tot}(25\text{ V})}$	4,3...6	4,5...6	
Parallelwiderstand bei $U_R = 3\text{ V}, f = 100\text{ MHz}$ bei $U_R = 3\text{ V}, f = 470\text{ MHz}$	r_p	24	> 10	kΩ
	r_p	> 0,85	0,6	kΩ
Grenzfrequenz für $Q = 1$ bei $U_R = 3\text{ V}$	f_{Q1}	20	10	GHz
Serienresonanzfrequenz bei $U_R = 25\text{ V}$	f_0	1,9	1,7	GHz
Serieninduktivität	L_s	2,5	2,5	nH
Sperrstrom bei $U_R = 15\text{ V}$ bei $U_R = 28\text{ V}$	I_R	50	50	nA
	I_R	< 1	< 1	μA
Durchbruchspannung	$U_{(BR)R}$	> 30	> 30	V